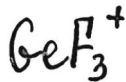


GeF₃



Harland P.W.;
et al.

1973

(7)

"Inorg. and Nucl. Chem. Lett"
1973, 9, n1, 53-58.

Две пр. глицероуксусной, по 5 мл. по 1 мл.

● (м. Ge^+ ; III)

1974

GeF_3 (радикал, ионы)

настр;
Ф.А. Емелин

Hollebone B.R.,
J. Chem Soc. Dalton Trans., 1974,
NI7, I889-98.

(ссыл. CH_3 ; III)

40515.3767
TE, Ch, MGU

GeF₃

40892

(A.P.)

1976

2076

Wang J. Ling-Fa1, Margrave J.L., Franklin
J.L.

Enthalpy of formation of germanium
trifluoride.

"J.Chem. Phys.", 1974, 60, N 5, 2158-1 2162

(англ.)

0101 671

088 091

99

ВИНИТИ

GeF₃

1988

neop. pac-
rem

Ar, Vo, I;

(+2) ~~2~~



SiF₃, CF₃

C.A. 1988, 109, N 24

199: 216185f Ab initio UHF and SW X α study of the trifluorogermyl and trifluorosilyl radicals. Moc, J.; Latajka, Z.; Latajczak, H. (Inst. Chem., Univ. Wroclaw, PL-50-383 Wroclaw, Pol.). Z. Phys. D: At., Mol. Clusters 1988, 9(4), 319-23 (Eng). Results of ab initio UHF and scattered-wave X α calcs. concerning the geometrical and electronic properties of the GeF₃ and SiF₃ radicals are presented. Comparison of the theor. ests. of inversion barriers, ionization potentials, and electron affinities obtained for three XF₃ radicals (X = Ge, Si, C) is made.

1988

3 2 Д117. Исследование радикалов GeF_3 и SiF_3 неэмпирическим неограниченным методом Хартри—Фока и методом $X\alpha$ рассеянных волн. Ab initio UHF and SW $X\alpha$ study of the GeF_3 and SiF_3 radicals / Moc J., Latajka Z., Ratajczak H. // Z. Phys. D.— 1988.— 9, № 4.— С. 319—323.— Англ.

Неэмпирическим методом ССП МО ЛКАО в рамках неограниченного хартри-фоковского подхода в базисе ОСТ-3ГФ и методом $X\alpha$ рассеянных волн в модели перекрывающихся сфер исследовано электронное строение радикалов GeF_3 (I) и SiF_3 (II). Для I длина связи равна 1,676 Å, валентный угол—103,6°, дипольный момент—1,99 ед. Дебая. Барьеры инверсии I и II оценены в 53,1 и 56,5 ккал/моль, что существенно больше, чем для CF_3 (16,2 ккал/моль) и GeH_3 (7,7). Первые потенциалы ионизации оценены в 9,2 (эксперим. значение 10,3) и 7,6 эВ (8,5—8,8), сродство к электрону—в 2,6 (1,1—3) и 1,5 (2,0—3,35) для I и II соответственно. Обсуждены положения одноэлектронных уровней и проведено сопоставление с CF_3 .

В. Л. Лебедев

 GeF_3

М.П.

(41) 181

ср. 1989, № 2

GeF_3^-

1991

Го-мберг
Барбер,
миср. рач.

Dixon D.A.,
Arcuengo A.J., et al
Heteroat. Chem.,
1991, 2, (5), 541-4

сеп. SiF_3^- (III)

1992

GeF₃

loc Jerzy, Rubżirski
Jerzy et al.,

et al.

Chem. Phys. 1992. 159.

N 2, c. 197-210.

(cur. ● SiH₃; III)

BeF₃

1998

Morgan, Nelson H., et al.,

(Ac)

J. Phys. Chem. A 1998,
102 (50), 10399-10403

meop.
pacem

(Cll. BeH₄; III)

CeF_3^-

1998

Morgan, Nelson H., et al.,

(A1)

J. Phys. Chem. A 1998,
102 (50), 10399-10403

neopem-
racem

(all: CeH_4 ,

● III)